PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-316831

(43) Date of publication of application: 05.12.1995

(51)Int.CI.

C23C 22/00

C23D 5/04

// C23C 26/00

(21)Application number: 06-132642

(71)Applicant:

KAISUI KAGAKU KENKYUSHO:KK

(22) Date of filing:

23.05.1994

(72)Inventor:

MIYATA SHIGEO

(54) CERAMIC COATING FILM FORMING AGENT AND ITS PRODUCTION

PURPOSE: To form a ceramic coating film having a low coefft. of thermal expan sion and excellent in heat resistance and electric insulating property on the surface of a metallic material at a lower temp. than the temp. at which an MgO coating film is formed by using a solid soln. of Mg-M3--O type binary oxide more excellent in reactivity than MgO as a coating film forming agent.

CONSTITUTION: Hydrotalcite compds. are fired to obtain the objective coating film forming agent contg. a solid soln. of Mg-M3--O type binary oxide represented by the formula as an effective component. The average secondary particle diameter of this coating film forming agent is regulated to $\leq 5 \mu$ m, preferably $\leq 1 \mu$ m and the BET specific surface area is regulated to about 30-200m2/g, preferably about flocculate and is satisfactorily dispersed in water, and CAA is regulated to for about 2-100min, preferably within a range of 0-60min.

 $(Mg_{1-1}M^{2^{-1}}) - M^{2^{-1}}, Q$ LAH M'HCa', Mn', Fe', Co', Ni ・、C g ** および Z g * 等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M2 はAT Mn! 、Te! of Night Tube Bir + Strace 等の主体 **金属から通ばれた少なくとも一種を示し、★は0≦★<**

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3475258

[Date of registration]

26.09.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-316831

(43)公開日 平成7年(1995)12月5日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 2 3 C	22/00	Α			
C 2 3 D	5/04	В			
// C23C	26/00	С			

		審査請求	未請求 請求項の数7 FD (全 6 頁)		
(21)出願番号	特願平6-132642	(71)出願人	391001664 株式会社海水化学研究所		
(22)出願日	平成6年(1994)5月23日	İ	福岡県北九州市八幡西区下畑町16番11号		
		(72)発明者	宮田 茂男		
			福岡県北九州市八幡東区西本町4-14-14		
		(74)代理人	弁理士 小林 正明		

(54) 【発明の名称】 セラミック被膜形成剤およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 MgOよりも反応性に優れ、より低い温度で耐熱性、電気絶縁性、低熱膨張率性等に優れたセラミック被膜を金属系材料上に形成できるMg-M³'-O系二元酸化物からなるセラミック被膜形成剤を提供する。

【構成】 式(1)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O\cdot Az$

[式中、 M^{2+} 、 M^{3+} 、x及びyは式(1)と同義、少なくとも一種を示し、Aはアニオン性酸化物を示し、zは $0 \le z < 0$. 5の範囲の数を表す]で表されるアニオン

 $* (Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O$ (1)

[式中、 M^{3+} は二価金属を示し、 M^{3+} は三価金属を示し、xは $0 \le x < 0$. 5、yは0 < y < 0. 5の範囲の数を表す]で表される $Mg - M^{3+} - O$ 系二元酸化物の固溶体を有効成分として含有する金属材料のセラミック被膜形成剤、及び式(1)の固溶体が、式(2)

(2)

性酸化物をさらに含有する金属材料のセラミック被膜形成剤、及びそれらの製造方法。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O$ (1)

[式中、M²゚はCa²゚, Mn゚゚, Fe²゚, Co²゚, Ni 21, Cu21およびZn21等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M³*はAl³*, Mn³*, Fe³*, C o³+, N i ³+, T i ³+, B i ³+およびC r ³+等の三価 金属から選ばれた少なくとも一種を示し、xは0≤x< 0.5、yは0<y<0.5の範囲の数を表す]で表さ れるMg-M**-〇系二元酸化物の固溶体を有効成分と 10 して含有する金属材料のセラミック被膜形成剤。

【請求項2】 M³ *がA 1 ³ *および/またはF e ³ *であ* $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O \cdot Az$

[式中、M''はCa'', Mn'', Fe'', Co'', Ni 2+, Cu2+およびZn2+等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M³*はA l ³*, M n ³*, F e ³*, C o³+, Ni³+, Ti³+, Bi³+およびCr³+等の三価 金属から選ばれた少なくとも一種を示し、Aはアニオン※

2+, Cu2+およびZn2+等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M³⁺はA l ³⁺, M n ³⁺, F e ³⁺, C o³+, Ni³+, Ti³+, Bi³+およびCr³+等の三価 金属から選ばれた少なくとも一種を示し、Bⁿ⁻はn価の アニオンを示し、xは0≤x<0.5、yは0<y< 5の範囲の数を表し、cは0≦c<0.5、mは0 ≦m<3の範囲の数を表す]で表されるハイドロタルサ イト類化合物を約700~1050℃で焼成することを 特徴とする請求項1記載のセラミック被膜形成剤の製造

【発明の詳細な説明】

[0001]

方法。

【産業上の利用分野】本発明は新規なセラミック被膜形 成剤およびその製造方法に関する。更に詳しくは、Mg Oよりも反応性に優れ、MgOよりも低い温度で耐熱 性、電気絶縁性、低熱膨張率性等に優れたセラミック被 膜を形成させることのできるMg-M'+-O系二元酸化 物固溶体の新規なセラミック被膜形成剤に関する。

[0002]

【従来の技術】MgOは高融点(約2800℃)のため 耐熱性に優れている共に、電気絶縁性が良く、無毒性で あり、しかも比較的安価である等の特徴を有している。 この特徴を生かして、主として金属材料の表面に、例え ば、必要に応じ他の成分と共に、水に分散させた後、ロ ール等を用いて塗布し、乾燥後焼成し、金属材料構成成 分と反応させて耐熱性、電気絶縁性等に優れた2MgO ·SiO, (フォルステライト)、MgA1,O, (スピ ネル) 等のようなセラミック被膜を形成させることが行 われている。この場合セラミック被膜に要求される特性 としては、経済性および下地金属の焼成雰囲気ガスによ 50 金属から選ばれた少なくとも一種を示し、xは0≦x<

2

* る請求項1記載の金属材料のセラミック被膜形成剤。 【請求項3】 平均二次粒子径が5μm以下、BET比 表面積が約30~200m'/gである請求項1記載の 金属材料のセラミック被膜形成剤。

【請求項4】 金属材料が電磁鋼板であり、セラミック 被膜がフォルステライト系である請求項1記載の金属材 料のセラミック被膜形成剤。

【請求項5】 CAAが2~100分である請求項1記 載の金属材料のセラミック被膜形成剤。

【請求項6】 式(1)で表されるMg-M³⁺-O系二 元酸化物の固溶体が、式(2)

(2)

※性酸化物を示し、xは0≤x<0.5、yは0<y</p> 0. 5、zは0≤z<0.5の範囲の数を表す]で表さ れるアニオン性酸化物をさらに含有する金属材料のセラ ミック被膜形成剤。

【請求項7】 式(3)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}(OH)_{2-nc}B^{n-}_{c}\cdot mH_{2}O$ (3)

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co²⁺, Ni 20 る変質を極力防止するため可及的低温でセラミック被膜 が形成されること、しかも生成したセラミック被膜が緻 密でムラがなく、かつ下地金属との密着性が良いこと等 が挙げられる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】MgOは融点が高いた め、かなり高温にならないと反応性が十分でなく、セラ ミック被膜を形成させるためには少なくとも約900℃ 以上の温度が必要である。このセラミック被膜生成温度 をできる限り低下させ、しかも緻密なセラミック被膜を 30 形成させるために、MgOの微粒子化、水への高分散化 等の努力が試みられてきたが、焼成温度約900℃とい う壁を破ることができないのが現状である。この温度を さらに低下させることができれば、単に省エネルギーと なるだけでなく、下地の金属材料の焼成雰囲気ガスによ る金属材料の焼成途中における変質を最小限に抑えると とができる。その結果、髙品質の金属材料、例えば電磁 鋼板を生産することができる。またMgOは、Mg(O H) 2の焼成温度に敏感であり、必要な温度よりも少し 低いと水和性が強くなり、下地金属の過酸化による品質 低下をもたらすことととなる。また焼成温度が必要な温 度よりも少し高いと、不活性となり、セラミック被膜の 形成性が著しく低下するという問題がある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、式(1)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O$ (1)

[式中、M''はCa'', Mn'', Fe'', Co'', Ni ²⁺, Cu²⁺およびZn²⁺等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M³*はAl³*, Mn³*, Fe³*, C o³+, N i ³+, T i ³+, B i ³+およびC r ³+等の三価

3

0.5、yは0<y<0.5範囲の数を表す]で表されるMg-M³*-O系二元酸化物の固溶体を有効成分とし*

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O \cdot Az$

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺およびZn²⁺等の二価金属から選ばれた少なくとも一種を示し、M³⁺はAl³⁺, Mn³⁺, Fe³⁺, Co³⁺, Ni³⁺, Ti³⁺, Bi³+およびCr³⁺等の三価金属から選ばれた少なくとも一種を示し、Aはアニオン※

[式中、 M^{2+} は Ca^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} および Zn^{2+} 等の二価金属から選ばれた少なくとも一種を示し、 M^{3+} は Al^{3+} , Mn^{3+} , Fe^{3+} , Co^{3+} , Ni^{3+} , Ti^{3+} , Bi^{3+} および Cr^{3+} 等の三価金属から選ばれた少なくとも一種を示し、 B^{n-} はn 価のアニオンを示し、xは $0 \le x < 0$. 5、yは0 < y < 0. 5の範囲の数を表し、cは $0 \le c < 0$. 5、mは $0 \le m < 3$ の範囲の数を表す]で表されるハイドロタルサイト類化合物を約 $700 \sim 1050$ Cで焼成することを

特徴とする上記のセラミック被膜形成剤の製造方法を提

供する。

【0005】本発明の式(1)で表されるMg-M³・-O系二元酸化物を有効成分として含有する金属材料の被膜形成剤は、MgOにAl等の三価金属が固溶した固溶体を主成分とする。該固溶体は、さらに式(2)で表されるガラス化形成能に優れたアニオン性酸化物を分子オーダーで均一に分散させた固溶体を含有することもできる。アニオン性酸化物としては、Si, BおよびP系酸化物等が例示され、より具体的にはSiOz, BzOzおよびPzOzが例示される。式(1)の二元酸化物は、極めて結晶が小さく、表面積が大きいため、反応性に極めて優れている。このためMgOよりもセラミック形成温度が大幅に低くなると共に、生成したセラミック被膜が緻密で厚く、かつ均一である。

【0006】MgOにM³*が固溶することにより、該固 溶体の結晶はMgOよりも微細かつ高比表面積になると 共に、格子欠陥濃度も増大している。これにより反応活 性が著しく増加したものと推定される。さらに固溶した M³+の酸化物はいずれもMgOよりも低融点であり、こ れも反応活性の増加に寄与したものと推定される。さら にSiO₂、B₂O₅およびP₂O₅のようなガラス形成に 効果的な成分を該固溶体に分子オーダーで均一に分散さ せることにより、反応活性の増加に寄与しているものと 推定される。そして全く意外なことに、該固溶体がMg 〇結晶よりも微結晶、高比表面積であるにも拘わらずC AAがMgOよりも何倍も長く、またMgOよりも水和 性が高いにも拘わらず下地金属の酸化がMgOよりも少 ないことである。これにより、水和を抑制するために分 散媒体である水の温度を低温に保つ、あるいは焼成時の 雰囲気の湿度を低く制御するといった特別の設備配慮が 不要となる。これにより、経済的であると共に、生産管 50

* て含有する金属材料のセラミック被膜形成剤を提供する。 さらに本発明は、式(2)

(2)

※性酸化物を示し、xは $0 \le x < 0$. 5、yは0 < y < 0. 5の範囲の数を表す]で表されるアニオン性酸化物をさらに含有する金属材料のセラミック被膜形成剤を提供する。本発明はさらに、式(3)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}(OH)_{2-n} B^{n-}_{c} \cdot mH_{2}O$ (3)

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co²⁺, Ni 10 理が容易である、品質が安定するといった利点をも有し **, Cu²⁺およびZn²⁺等の二価金属から選ばれた少な ている。

> 【0007】本発明の式(1)で表されるセラミック被 膜形成剤は、MgO、またはMgOに二価の酸化物を固 溶したものに三価の酸化物であるM'', O, が固溶したも のである。この固溶体の結晶構造は、MgOと同じであ る。少量のスピネル型MgM³⁺、O4等のMgO以外の酸 化物が共存していてもよい。ただし、好ましくは共存し ない方がよい。このスピネルの存在は、M³⁺の量が多く なった場合、あるいは本発明のセラミック被膜形成剤の 製造時における焼成温度が約900℃よりも高くなった 20 場合に認められる。MgOに固溶するM'+としてはA1 3, Mn3, Fe3, Co3, Ni3, Ti3, Bi3 +およびCr3+等の三価金属の中から選ばれた少なくと も一種が使用される。最も好ましいのはA 1 3 tおよびF e³*である。MgOに固溶するM²*としては、Ca²*, Mn²+, Fe²+, Co²+, Ni²+, Cu²+およびZn²+ 等の二価金属から選ばれた少なくとも一種が使用され る。MgOに対してM³*の固溶は必須の要件であり、こ の固溶によりMg〇の結晶成長が抑制される。これによ り、セラミック被膜形成剤製造時の焼成温度が約700 ~1050℃という広い範囲にわたって微細な結晶粒子 が得られ、また約30~200㎡/gという高い比表 面積を示すこととなる。M**の上記効果は、固溶量が多 いほど増加する。

> 【0008】式(2)で表されるアニオン性酸化物を分 散状態で含有する化合物のAとして表示されるアニオン 性酸化物は、Si, BおよびP系酸化物が例示される。 具体的にはSiO、、B、O、およびP、O、等の中から選 ばれた少なくとも一種が使用される。AはMg-M³⁺-40 〇系固溶体に分子オーダーで分散しており、ケイ酸成 分、ホウ酸成分、リン酸成分とも換言することができ る。これらの成分は、いずれもMg-M'+-O系固溶体 の融点を下げる効果を有する。その結果、セラミック被 膜形成温度の低下、被膜の緻密化に寄与することとな る。また同時にセラミック被膜の構成成分ともなる。こ れらの成分は比較的少量でも効果があり、配合量を多く してもさらなる効果の向上は少ない。M''としては、C a'+, Mn'+, Fe'+, Co'+, Ni'+, Cu'+および Z n ' * 等の二価金属から選ばれた少なくとも一種が使用 される。M'+のMgOに対する固溶量は、式(1)にお

いて、0≦x<0.5であり、特に好ましくは0≦x< 0. 2の範囲である。M³+のMgOに対する固溶量は、 式(1)において、0<y<0.5、好ましくは0.0 5 ≤ y < 0.4、特に好ましくは0.1 ≤ y < 0.3で 示される範囲である。式(2)において、Aの配合量 は、 $0 \le z < 0$. 5、好ましくは0. $0 2 \le z \le 0$. 2 で示される範囲である。本発明のセラミック被膜形成剤 は、凝集が少なく、水に対し良く分散することが好まし*

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}(OH)_{2-nc}B^{n-}_{c}\cdot mH_{2}O$

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co²⁺, Ni 10 または両面に均一に塗布する。塗布手段としては、ロー 2+, Cu2+およびZn2+等の二価金属から選ばれた少な くとも一種を示し、M³*はAl³*, Mn³*, Fe³*, C o³+, N i ³+, T i ³+, B i ³+ およびC r ³+等の三価 金属から選ばれた少なくとも一種を示し、B"ない価の アニオン、例えばCO,'-, HPO,'-, SiO,'-, B, O,'-を示し、xは0≤x<0.2、yは0<y<0. 5の範囲の数を表し、cは0≤c<0.5、mは0≤m <3の範囲の数を表す]で表されるハイドロタルサイト 類化合物を約700~1050℃、好ましくは約800 ~900℃で、約0.1~10時間、好ましくは約0. 5~2時間焼成することにより製造できる。焼成温度が 700℃未満であると過酸化物となり下地金属が錆びる 欠点が発生し易い。また焼成温度が1050℃を超える と結晶が粗大化すると共に副生するスピネルが成長して 不活性となり、セラミック皮膜形成性が悪くなる。n価 のアニオンB"でが揮発性の場合、例えばC1で,N O, -, CO, 1-, C, O, 1-等の場合には、焼成物は式 (1)の化合物となる。アニオンB"が不揮発性の場 合、例えばHPO4²-, B4O,²-, SiO,²-の場合に は、焼成物は式(2)の化合物となる。焼成雰囲気に特 別の条件はなく、大気中の雰囲気で焼成してもよい。焼 成は、例えば、ロータリーキルン、トンネル炉、流動培 焼炉、マッフル炉等の設備を用いて実施できる。ハイド ロタルサイト類化合物の製造方法は公知であり(特公昭 47-32198号、特公昭48-29477号公 報)、例えば二価および三価金属の水溶性金属塩の混合 水溶液にNaOH、Ca(OH),等のアルカリをほぼ 当量加えて反応させることにより製造できる。この場 合、二価および三価金属が目的とするB"-と異なる場合 には、n 価のアニオンB" - の水溶液を共存させて反応さ せることもできる。また上記反応物を、さらにオートク レーブに入れ、約100~250℃で約1~20時間水 熱処理することにより、凝集が少ない微粒子を生成させ ることもできる。

【0010】次に本発明のセラミック被膜形成剤の使用 方法について説明する。セラミック被膜形成剤を分散手 段を用いて水に均一に分散させる。分散手段としては、 撹拌機、ホモミキサー、コロイドミル、好ましくはコロ イドミル等の慣用の手段が採用され、特に制限されるも のではない。分散液を目的とする金属系材料の板の片面 50

*い。このため平均二次粒子径が5μm以下、好ましくは 1μm以下であり、ΒΕΤ比表面積が約30~200m '/g、好ましくは約50~150m'/gの範囲にある ことが好ましい。CAAは約2~100分、好ましくは 10~60分の範囲にあることが好ましい。

【0009】本発明のセラミック被膜形成剤の製造方法 を次に説明する。式(3)

(3)

ル、ドクターブレード等の慣用の手段が採用され、特に 制限されるものではない。塗布、乾燥後、通常非酸化ま たは還元雰囲気中で、約800℃以上約1300℃以下 で焼成することにより、目的とするセラミック被膜が形 成される。水に分散させる段階で、本発明のセラミック 被膜形成剤と共に、MgO成分、SiOz成分および/ またはA1,O,成分を添加し、良く分散して用いること もできる。SiO,成分およびAl,O,成分としては、 コロイダルシリカ、ケイ酸、メチルシリケート、エチル 20 シリケート、スメクタイト、アルミナゾル、アルミニウ ムアルコラート等が例示される。

【0011】本発明のセラミック被膜形成剤は、水に分 散させることなく、例えば、セラミック溶射法等により 金属系材料に直接溶射して目的とする被膜を形成させる こともできる。本発明のセラミック皮膜形成剤は、電磁 鋼板用焼鈍分離剤としての使用にも適している。金属系 材料としては、Fe, Al, CuおよびZn等の金属 板、電磁鋼板 (ケイ素鋼板)等が例示される。生成され たセラミック被膜は、MgO-SiO₂系および/また はMg〇-A1,〇,系であり、具体的には次のものが例 示される。フォルステライト (Mg, SiO,、Fe, S iO₁)、スピネル (MgA12O₁)、コージェライト (2MgO·2A1,O,·5SiO,)等。以下実施例 に基づき本発明をより詳細に説明する。各例において% および部は特に断りの無い限り重量%、重量部を意味す

【0012】実施例1

組成式Mg。,,Al。,,(OH),(CO,),,,,,,,,, 0.9H,Oで表されるハイドロタルサイト類化合物の 粉末を、電気炉を用い、850℃で1時間焼成した。焼 成物について、化学組成、BET比表面積(液体窒素吸 着法)、CAAおよび粉末X線回折を測定した。なおC AAとは、0.4Nクエン酸水溶液100m1を入れた 200m1容積のビーカーに、試料粉末2.0gを加え た後、マグネチックスターラーで撹拌し、30℃でpH が8に到達するまでの時間を意味する。その結果、焼成 物はMgOと同じ結晶構造を有する化学組成がMg。。。 Al.。。OのMg-Al-O系固溶体であり、BET比 表面積は51m¹/gであった。MgOにA1が固溶し ていることは、MgOよりもX線回折パターンが高角度

側にシフトしていることで明らかである。この焼成物とコロイダルシリカをそれぞれ脱イオン水に120g/1、40g/1の濃度となるように添加後、15℃で40分間ホモミキサーで均一に分散した。得られたスラリーを、セラミック(ガラス)被膜を除去した市販のケイ素鋼板の両面にゴムローラーで塗布した後、300℃の乾燥機に入れ、60秒間乾燥した。この鋼板を窒素雰囲気中、電気炉を用いて5℃/分の昇温速度で加熱し、フォルステライトが生成し始める温度をX線回折により調べた。焼成物の評価結果を表1に示す。

[0013]C:0.053%, Si:3.05%, M n:0.065%、S:0.024%、残部:不可避不 純物とFeからなる方向性電磁鋼板用素材スラブを公知 の方法により、熱延と焼鈍をはさむ2回の冷延により最 終厚さ0.29mmの板を作成した。次いで窒素と水素 の混合雰囲気下で脱炭焼鈍して酸化層を形成した後、コ ロイドミルを用いて水に分散させた本発明のセラミック 皮膜形成剤を塗布し、1200℃×20時間の最終焼鈍 を行った。この後、連続ラインにおいて絶縁被膜剤とし て50%リン酸Mg100部と20%コロイダルシリカ 200部からなる液を塗布し、850℃で焼付と歪取り を行った。被膜特性と磁気特性の評価結果を表2に示 す。表2は、本発明のセラミック被膜形成剤を用いた場 合には、被膜特性として均一性、密着性、被膜張力が極 めて優れ、磁気特性も比較材である従来のMgOを用い た場合に比して極めて優れていることを示している。

【0014】実施例2

化学組成: Mg., Al., O

焼成物の結晶構造、BET比表面積、水和量およびフォルステライト生成開始温度を表1に示す。実施例1と同様に操作して電磁鋼板に塗布したときの被膜特性、磁気特性を表2に示す。

【0015】実施例3

組成式Mg。.。Zn。.,Al。.,(OH),(CO,)。.,, ・0.55H,Oで表されるハイドロタルサイト類化合 * * 物の粉末を、電気炉を用い、840℃で1時間焼成した。

化学組成: Mg。, Zn。, Al。, O

焼成物の評価結果を表1に示す。実施例1と同様に操作 して電磁鋼板に塗布したときの被膜特性、磁気特性を表 2に示す。

【0016】実施例4

組成式Mg.,,Al.,,Fe.,,(OH),(CO₃)。.,, O. 85H,Oで表されるハイドロタルサイト類 10 化合物の粉末を、電気炉を用い、840℃で1時間焼成した。

化学組成:Mgo.o, Alo.ioFeo.o, O 焼成物の評価結果を表1に示す。実施例1と同様に操作 して電磁鋼板に塗布したときの被膜特性、磁気特性を表 2に示す。

【0017】実施例5

組成式Mg., Al., (OH), (CO,), (HPO ,), (s, o), (HPO ,), (s, o), (65H, Oで表されるハイドロタルサイト 類化合物の粉末を電気炉を用い、900℃で1時間焼成 した。

化学組成: Mg。。。Al。、2。(P2O5)。。。25 焼成物の評価結果を表lに示す。実施例lと同様に操作 して電磁鋼板に塗布したときの被膜特性、磁気特性を表 2に示す。

【0018】比較例1

水酸化マグネシウムの粉末を電気炉を用い、900℃で 1時間焼成した。得られた酸化マグネシウムの評価結果 を表1に示す。実施例1と同様に操作して電磁鋼板に塗 布したときの被膜特性、磁気特性を表2に示す。

30 【0019】比較例2、3

実施例3で用いたハイドロタルサイト類化合物の粉末を電気炉を用い、600℃で1時間(比較例2)、1100℃で1時間(比較例3)焼成した。

化学組成: Mg。.。Zn。.1Al。.3O

焼成物の評価結果を表1に示す。実施例1と同様に操作 して電磁鋼板に塗布したときの被膜特性、磁気特性を表 2に示す。

[0020]

表1

	衣 1					
	X線回折	ВЕТ	フォルステライト	CAA		
	パターン	(m²/g)	生成開始	(秒)		
			温度 (℃)			
実施例1	ΜgΟ	5 1	750	220		
2	ΜgΟ	73	750	925		
3	MgO	102	700	2072		
4	MgO	9 1	700	488		
5	MgO%	150	700	990		
比較例1	MgO	20	900	6 5		
2	MgO	220				
3	ΜgΟ,	(MgZn) A	120.	1260		

10

注:MgO※;MgOと微少量のMgAl,O,の回折X

* [0021]

850

4200

線回折バターンを示した。

ж

主り

38

			表艺		
	被膜外観	密着性	被膜張力	磁気特	性
			(kg/mm²)	$B_s(T)$	\overline{W}_{17} (w/kg)
実施例1	В	В	0.38	1.85	1.18
2	Α	Α	0.50	1.86	1.14
3	Α	Α	0.63	1.87	1.10
4	Α	Α	0.55	1.87	1.15
5	Α	Α	0.57	1.87	1.12
比較例1	С	Α	0.18	1.83	1.24
2	С	В	0.26	1.83	1.20
3	С	С	0.20	1.83	1.22

注:被膜外観(最終焼鈍後のガラス被膜の形成状態)

A:均一で厚く、光沢有り

B:ほぼ均一で良好

C:やや薄く、僅かに金属光沢の露出部有り

密着性(20mmφ曲げ)

A:全く剥離なし B:僅かに剥離有り

C:剥離部多く金属面露出している。

[0022]

【発明の効果】本発明によれば、MgOよりも反応性に優れ、より低い温度で耐熱性、電気絶縁性、低熱膨張率性等に優れたセラミック被膜を金属系材料上に形成できるMg-M³'-O系二元酸化物からなるセラミック被膜形成剤が提供される。本発明によれば、金属系材料上に

20 生成したセラミック被膜が、緻密かつ均一であり、かつ 金属系材料との密着性に優れたセラミック被膜を金属系 材料上に形成できるセラミック被膜形成剤が提供され る。 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成13年11月22日(2001.11.22)

【公開番号】特開平7-316831

【公開日】平成7年12月5日(1995.12.5)

【年通号数】公開特許公報7-3169

【出願番号】特願平6-132642

【国際特許分類第7版】

C23C 22/00

C23D 5/04

// C23C 26/00

[FI]

C23C 22/00

C23D 5/04

C23C 26/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成13年4月16日(2001.4.1

6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

*【補正方法】変更 【補正内容】 【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(2)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O\cdot Az$ (2)

[式中、M²⁺ はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co ^{2 +} , N i ^{2 +} , C u ^{2 +} および Z n ^{2 +} 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1^{3 +}, Mn^{3 +}, Fe^{3 +}, Co^{3 +}, Ni^{3 +} i³⁺, Bi³+およびCr³⁺等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、Aは分子オーダーで固溶体 中に均一に分散しているSiO。及びPO。以外のS i, B又はPの酸化物を含むアニオン性酸化物を示し、 $xt0 \le x < 0.5$, yt0 < y < 0.5, $zt0 \le z$ <0.5(但しz=0を除く)の範囲の数を表す]で表 されるアニオン性酸化物の分散したMg-M³+-O系 二元酸化物の固溶体を有効成分として含有する金属材料 のセラミック被膜形成剤。

【請求項2】 M³ + が、A 1³ + および/またはF e 3 ⁺ である請求項1記載の金属材料のセラミック被膜形 成剤。

【請求項3】 アニオン性酸化物の分散したMg-M ※

※^{3 +} -O系二元酸化物の固溶体が、平均二次粒子径が5 μm以下、BET比表面積が約30~200m²/gで ある請求項1記載の金属材料のセラミック被膜形成剤。 【請求項4】 該被膜形成剤が、電磁鋼板にフォルステ ライト系のセラミック被膜を形成できる請求項1記載の

【請求項5】 CAAが2~100分である請求項1記 載の金属材料のセラミック被膜形成剤。

【請求項6】 Aが、HPO4 2 - , B4 O7 2 - , S iO₂, B₂O₃及びP₂O₅から選ばれた少なくとも 一種の酸化物である請求項1記載の金属材料のセラミッ ク被膜形成剤。

【請求項7】 Aが、SiO2, B2O3及びP2O5 から選ばれた少なくとも一種の酸化物である請求項6記 載の金属材料のセラミック被膜形成剤。

【請求項8】 式(3)

金属材料のセラミック被膜形成剤。

 $(Mg_{1-x}M^{2+x})_{1-y}M^{3+y}$ (OH) 2-nc B^{n-c} · mH₂ O (3)

[式中、M²⁺ はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co ² + , N i ² + , C u ² + および Z n ² + 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1^{3 +} , Mn^{3 +} , Fe^{3 +} , Co^{3 +} , Ni^{3 +} i³+, Bi³+およびCr³+ 等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、B^{n ~} はSiO。及びPO 。以外のSi, B又はPの酸化物を含むn価のアニオン

性酸化物を示し、xは $0 \le x < 0$. 5、yは0 < y <0.5の範囲の数を表し、cは0≤c<0.5<u>m</u>は0 ≦m<3の範囲の数を表す]

で表されるハイドロタルサイト類化合物を約700~1 050℃で焼成することを特徴とする請求項1記載のア ニオン性酸化物の分散したMg-M³ + -〇系二元酸化 物の固溶体を有効成分として含有する金属材料のセラミ

ック被膜形成剤の製造方法。

* *【請求項9】 式(4)

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}(OH)_{2-nc}B^{n-}_{c}\cdot mH_{2}O$

(4)

[式中、M^{2 +} はCa^{2 +}, Mn^{2 +}, Fe^{2 +}, Co ² ⁺ , N i ² ⁺ , C u ² ⁺ および Z n ² ⁺ 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA l^{3 +}, Mn^{3 +}, Fe^{3 +}, Co^{3 +}, Ni^{3 +} i³+, Bi³+およびCr³+ 等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、B * - は n 価のアニオンを ※

式(1) 0

 $(Mg_1 - x M^2 + x)_1 - y M^3 +$ [式中、M^{2 +} はCa^{2 +} , Mn^{2 +} , Fe^{2 +} , Co ² + , N i ² + , C u ² + および Z n ² + 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1³ + , Mn³ + , Fe³ + , Co³ + , Ni³ + , T i³+, Bi³+およびCr³+等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、xは0≤x<0.5、yは 0<y<0.5の範囲の数を表す]

で表されるMg-M³+-O系二元酸化物の固溶体を有 効成分として含有する金属材料のセラミック被膜形成剤 の製造方法。

【請求項10】 式(2)のアニオン性酸化物の分散し たMg-M³+-O系二元酸化物の固溶体の水性分散液 を金属材料の表面に塗布し、塗布膜を乾燥し、焼成する ことからなる金属材料上へのセラミック被膜の形成方 法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}$

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co ^{2 +} 、Ni^{2 +} 、Cu^{2 +} およびZn^{2 +} 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1³ + , Mn³ + , Fe³ + , Co³ + , Ni³ + , T i ³ + 、B i ³ + およびC r ³ + 等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、Aは分子オーダーで固溶体 中に均一に分散しているSiO。及びPO。以外のS ☆

(3)

[式中、M²⁺はCa²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Co ²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺ および Zn²⁺ 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1³ + , Mn³ + , Fe³ + , Co³ + , Ni³ + , T i³+, Bi³+およびCr³+等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、B° c はSiO。及びPO 」以外のSi, B又はPの酸化物を含むn価のアニオン 性酸化物を示し、xは0≦x<0.5、yは0<y<

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}$ $(OH)_{2-n}cB^{n-}_{c} \cdot mH_{2}O$ (4)

^{2 +} , N i ^{2 +} , C u ^{2 +} および Z n ^{2 +} 等の二価金属

[式中、M^{2 +} はCa^{2 +} , Mn^{2 +} , Fe^{2 +} , Co

※示し、xは0≤x<0.5、yは0<y<0.5の範囲 の数を表し、cは0≤c<0.5、mは0≤m<3の範 囲の数を表す〕

で表されるハイドロタルサイト類化合物を約700~1 050℃で焼成することからなる、

(1)

★【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は新規なセラミック被膜形 成剤およびその製造方法に関する。更に詳しくは、Mg Oよりも反応性に優れ、MgOよりも低い温度で耐熱 性、電気絶縁性、低熱膨張率性等に優れたセラミック被 膜を形成させることのできるMg-M³+-O系二元酸 化物固溶体の新規なセラミック被膜形成剤及びその製造 方法に関する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、式(2)

(2) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{O} \cdot \mathbf{A} \mathbf{z}$

> ☆ i B又はPの酸化物を含むアニオン性酸化物を示し、 $x \text{ ti } 0 \le x < 0.5, y \text{ ti } 0 < y < 0.5, z \text{ ti } 0 \le z$ <0.5(但しz=0を除く)の範囲の数を表す]で表 されるアニオン性酸化物の分散したMg-M³+-O系 二元酸化物の固溶体を有効成分として含有する金属材料 のセラミック被膜形成剤を提供する。本発明はさらに、 式(3)

 $(Mg_{1-x}M^{2+x})_{1-y}M^{3+y}$ $(OH)_{2-n}$ B^{n-c} $mH_{2}O$

◆0.5の範囲の数を表し、cは0≤c<0.5、mは0</p> ≦m<3の範囲の数を表す]で表されるハイドロタルサ イト類化合物を約700~1050℃で焼成することを 特徴とする式(2)で表されるアニオン性酸化物の分散 したMg-M³+-O系二元酸化物の固溶体を有効成分 として含有する金属材料のセラミック被膜形成剤の製造 方法を提供する。本発明はさらに、式(4)

から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1³ + , Mn³ + , Fe³ + , Co³ + , Ni³ + , T

- 補 2-

i³+, Bi³+およびCr³+等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、Bⁿ⁻ はn価のアニオンを 示し、xは0≦x<0.5、yは0<y<0.5の範囲 の数を表し、cは0≤c<0.5、mは0≤m<3の範*

 $(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}O$

[式中、M² + はCa² + , Mn² + , Fe² + , Co ² ⁺ , N i ^{2 +} , C u ^{2 +} および Z n ^{2 +} 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1^{3+} , Mn^{3+} , Fe^{3+} , Co^{3+} , Ni^{3+} , Ti³+, Bi³+およびCr³+ 等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、xは0≦x<0.5、yは 0 < y < 0.5の範囲の数を表す]で表されるMg-M 3 + -O系二元酸化物の固溶体を有効成分として含有す る金属材料のセラミック被膜形成剤の製造方法を提供す る。本発明はさらに、式(2)のアニオン性酸化物の分 散したMg-M3+-O系二元酸化物の固溶体の水性分 散液を金属材料の表面に塗布し、塗布膜を乾燥し、焼成 することからなる金属材料上へのセラミック被膜の形成 方法を提供する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正内容】

【0005】本発明のMg-M³+-O系二元酸化物を 有効成分として含有する金属材料の被膜形成剤は、Mg OにA 1等の三価金属が固溶した固溶体を主成分とす る。該固溶体は、式(2)で表されるようにガラス化形 成能に優れたアニオン性酸化物を分子オーダーで均一に 分散させた固溶体である。アニオン性酸化物としては、 SiO。及びPO。以外のSi. BおよびP系酸化物等 が例示され、より具体的にはSiO2, B2O3 および P2 O5 が例示される。式(4)のハイドロタルサイト 類化合物から得られる式(1)の二元酸化物は、極めて 結晶が小さく、表面積が大きいため、反応性に極めて優 れている。このためMgOよりもセラミック形成温度が 大幅に低くなると共に、生成したセラミック被膜が緻密 で厚く、かつ均一である。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】式(2)で表されるアニオン性酸化物を分※

$$(Mg_{1-x}M^{2+}_{x})_{1-y}M^{3+}_{y}(OH)_{2-n}cB^{n-}_{c}mH_{2}O$$
(3)

[式中、 M^{2} + は Ca^{2} + , Mn^{2} + , Fe^{2} + , Co²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺ および Zn²⁺ 等の二価金属 から選ばれた少なくとも一種を示し、M³ + はA 1³ + , Mn³ + , Fe³ + , Co³ + , Ni³ + , T *囲の数を表す]で表されるハイドロタルサイト類化合物 を約700~1050℃で焼成することからなる、 式(1)

(1)

※ 散状態で含有する化合物のAとして表示されるアニオン 性酸化物は、SiO。及びPO。以外のSi, Bおよび P系酸化物が例示される。具体的にはSiO2、B2O ₅およびP₂O₅等の中から選ばれた少なくとも一種が 使用される。AはMg-M³+-O系固溶体に分子オー ダーで分散しており、ケイ酸成分、ホウ酸成分、リン酸 成分とも換言することができる。これらの成分は、いず れもMg-M³+-O系固溶体の融点を下げる効果を有 する。その結果、セラミック被膜形成温度の低下、被膜 の緻密化に寄与することとなる。また同時にセラミック 被膜の構成成分ともなる。これらの成分は比較的少量で も効果があり、配合量を多くしてもさらなる効果の向上 は少ない。M^{2 +} としては、Ca^{2 +} , Mn^{2 +} , Fe ^{2 +} , Co^{2 +} , Ni^{2 +} , Cu^{2 +} およびZn^{2 +} 等 の二価金属から選ばれた少なくとも一種が使用される。 M² + のMgOに対する固溶量は、式(1)において、 $0 \le x < 0$. 5 であり、特に好ましくは $0 \le x < 0$. 2 の範囲である。M³ + のMgOに対する固溶量は、式 (1) において、0<y<0.5、好ましくは0.05 ≦y<0.4、特に好ましくは0.1≦y<0.3で示</p> される範囲である。式(2)において、Aの配合量は、 0 < z < 0.5、好ましくは $0.02 \le z \le 0.2$ で示 される範囲である。本発明のセラミック被膜形成剤は、 凝集が少なく、水に対し良く分散することが好ましい。 このため平均二次粒子径が5μm以下、好ましくは1μ m以下であり、BET比表面積が約30~200m²/ g、好ましくは約50~150m²/gの範囲にあるこ とが好ましい。CAAは約2~100分、好ましくは1 0~60分の範囲にあることが好ましい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】本発明の式(2)で示すセラミック被膜形 成剤又は式(1)で示すMg-M³+-O系二元酸化物 固溶体の製造方法を次に説明する。

式(3)

i³+, Bi³+およびCr³+等の三価金属から選ば れた少なくとも一種を示し、Bⁿ⁻ はSiO。及びPO y以外のSi,B又はPの酸化物を含むn価のアニオン 性酸化物を示し、例えばCO。2 - , HPO。2 - , B

4 O₇ ^{2 -} を示し、xは0 ≤ x < 0.2、yは0 < y < 0.5の範囲の数を表し、cは0≤c<0.5、mは0 ≦m<3の範囲の数を表す]で表されるハイドロタルサ イト類化合物を約700~1050℃、好ましくは約8 00~900℃で、約0.1~10時間、好ましくは約 0.5~2時間焼成することにより製造できる。式 (1)の二元酸化物固溶体は式(4)の化合物を、式 (3) の化合物から式(2) の化合物を製造する場合と 同様の条件で製造できる。焼成温度が700℃未満であ ると過酸化物となり下地金属が錆びる欠点が発生し易 い。また焼成温度が1050℃を超えると結晶が粗大化 すると共に副生するスピネルが成長して不活性となり、 セラミック皮膜形成性が悪くなる。n価のアニオンB ^{n -} が揮発性の場合、例えばCl⁻, NO_s-, CO_s ² - , C₂ O₄ ² - 等の場合には、焼成物は式(1)の 化合物となる。アニオンBⁿ が不揮発性の場合、例え ぱHPO42-, B4O72-の場合には、焼成物は式 (2) の化合物となる。焼成雰囲気に特別の条件はな く、大気中の雰囲気で焼成してもよい。焼成は、例え ば、ロータリーキルン、トンネル炉、流動培焼炉、マッ フル炉等の設備を用いて実施できる。ハイドロタルサイ ト類化合物の製造方法は公知であり(特公昭47-32 198号、特公昭48-29477号公報)、例えば二 価および三価金属の水溶性金属塩の混合水溶液にNaO H、Ca(OH)2等のアルカリをほぼ当量加えて反応 させることにより製造できる。この場合、二価および三 価金属が目的とするBⁿ⁻ と異なる場合には、n 価のア ニオンB^{® -} の水溶液を共存させて反応させることもで きる。また上記反応物を、さらにオートクレーブに入 れ、約100~250℃で約1~20時間水熱処理する ことにより、凝集が少ない微粒子を生成させることもで きる。

【手続補正7】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0012 【補正方法】変更 【補正内容】

【0012】実施例1 組成式Mgo. ssAlo. os(OH)2(COs) o. o 2 5 ・ O. 9 H 2 Oで表されるハイドロタルサイ ト類化合物の粉末を、電気炉を用い、850℃で1時間 焼成した。焼成物について、化学組成、BET比表面積 (液体窒素吸着法)、 CAAおよび粉末X線回折を測定 した。なおCAAとは、0.4Nクエン酸水溶液100 m1を入れた200m1容積のビーカーに、試料粉末 2.0gを加えた後、マグネチックスターラーで撹拌 し、30℃でpHが8に到達するまでの時間を意味す る。その結果、焼成物はMgOと同じ結晶構造を有する 化学組成がMgo. g 5 A lo. o 5 Oo. 1 2 5 のM g-Al-O系固溶体であり、BET比表面積は51m ² /gであった。MgOにAlが固溶していることは、 MgOよりもX線回折パターンが高角度側にシフトして いることで明らかである。この焼成物とコロイダルシリ カをそれぞれ脱イオン水に120g/1、40g/1の 濃度となるように添加後、15℃で40分間ホモミキサ ーで均一に分散した。得られたスラリーを、セラミック (ガラス)被膜を除去した市販のケイ素鋼板の両面にゴ ムローラーで塗布した後、300℃の乾燥機に入れ、6 0秒間乾燥した。この鋼板を窒素雰囲気中、電気炉を用 いて5℃/分の昇温速度で加熱し、フォルステライトが 生成し始める温度をX線回折により調べた。焼成物の評 価結果を表1に示す。